

10Gbps InGaAs PIN PD Chip φ50um



产品描述

InGaAs PIN 高速光探测器芯片

产品特点

Φ50um 有效面积; 高响应度; 正面正极/负极焊盘

应用领域

IEEE 40Gbps Ethernet | 4x10G CWDM4 | 40G SFP+LR4 | 光纤数据通信

核心参数

无
无



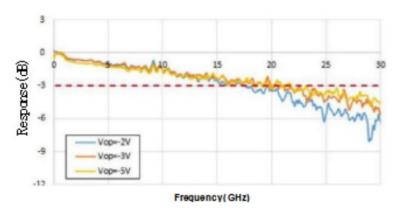








详细参数



规格(Tc=25°C,单颗裸芯片)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
响应范围	λ	900		1650	nm	
响应度	R	0.8	0.95		A/W	λ=1310-1550nm
暗电流	I _D		0.08	0.3	nA	V _R =-5V
电容	С		0.12	0.2	pF	V _R =-2V,f=1MHz
井安	带宽 Bw 10	GHz	V _R =-2V			
带见			10	GHZ	GHZ	3dB down,RL=50Ω
有效区直径	D		50		um	
通道之间的中心间距(pitch)			250		um	